### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-297203

(43) Date of publication of application: 24.12.1987

(51)Int.CI.

C01B 21/064 C30B 29/38

(21)Application number: 61-142256

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

17.06.1986

(72)Inventor: DEGAWA JUNJI

YATSU SHUJI

# (54) METHOD FOR SYNTHESIZING HIGH-QUALITY SINGLE CRYSTAL OF CUBIC BORON NITRIDE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled large-sized single crystal of mm size in high reproducibility, by pressurizing and heating raw material BN and a specific solvent substance in the presence of cubic BN seed crystal.

CONSTITUTION: An alkaline (earth) metal borate is blended with 1W10wt% Li3N and/or Li3BN2 and 5W30wt% one more selected from Sr3N2, Ba3N2, Sr3B2N4 and Ba3B2O4 to give a solvent substance. Then raw material BN and the solvent substance are heated and pressurized in the presence of cubic BN seed crystal under stable temperature and temperature conditions at  $\geq$  the melting point of the solvent substance.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

卵日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 297203

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)12月24日

C 01 B 21/064 30 B 29/38

7508-4G 8518-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

60発明の名称

高品質立方晶型窒化硼素単結晶の合成方法

の特 願 昭61-142256

22出 願 昭61(1986)6月17日

Ш 明 出 ⑫発 者

伊丹市昆陽北1丁目1番1号 住友電気工業株式会社伊丹 司

製作所内

79発 明 者

示

純

伊丹市昆陽北1丁目1番1号 住友電気工業株式会社伊丹

製作所内

住友電気工業株式会社 の出

弁理士 上代 哲司 理 MHC.

大阪市東区北浜5丁目15番地

阴 知

発明の名称

高品質立方晶型窒化硼素単結晶の合成方法

- 特許請求の範囲
- 立方品型窒化硼素種結晶の存在下、原料窒 化硼素と溶媒物質を併存させ立方晶型窒化硼素が 安定な圧力、温度条件下で且つ溶媒物質の融点以 上の温度で、立方晶型窒化硼素を合成するにあた り、前記浴媒物質としてアルカリ金属の硼酸塩。 アルカリ土類金属の硼酸塩の1種以上、LiaN. LiaBN2の1種以上、SraNa.BaaNa.SraBaN4.BaaBaN4 の1種以上の混合物を用いることを特徴とする高 品質立方晶型整化硼素単結晶の合成方法。
- LiaN, LiaBNaの1種以上が1~10重量%、 Sr.N., Ba.N., Sr.B.N., Ba.B.N. の1 種以上が5~ 30重量%残部がアルカリ金属の硼酸塩、アルカリ 土類金属の硼酸塩の1種以上である特許請求の範 囲第1項記載の高品質立方品型窒化硼素単結晶の 合成方法。
- 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

立方晶型窒化硼素(以下CBNと記す)はダイヤ モンドに次ぐ硬度を有し、鉄系材料の研削加工用 砥粒として人工合成されたものが広く用いられて いる。 最近合成技術が進歩 し20/30 U S メッシュ サイズの単結晶粉末が合成されるようになった。 CBNのダイヤに対する有利な点は、鉄族金属と の反応性が少ない点である。ダイヤモンドは既に 1 カラットを越える直径 6 mm以上の単結晶が超高 圧下での合成に成功している。近年俎精密加工技 術への要求が強まり、ダイヤモンドの単結晶を用 いたパイトが広く用いられているが、前迩した如 く鉄系材料との反応性の為にこれ等の超精密加工 を行なうことが出来ず、ダイヤモンドに替る工具 材の阴発が望まれていた。

本発明はこのような用途にも使用できる大型のC BN単結晶を再現性良く合成する方法に関するも のである。

従来の技術とその問題点

CBNの合成は通常、六方品型窒化硼炭(以下

トBNと記す)を原料とし、アルカリ金属、アルカリ土類金属、またはこれ等の窒化物、砂窒化物を触媒とし、超高圧高温下で行なわれる。良く用いられる触媒としてはしi、Mg、Ca、Li。N、Mg。Na、Ca。BaNa、符である。合成に当ってトBNとこれ等の触媒物質との混節に充近に当ってカBNとこれ等の触媒物質との混節に発症に示したCBNの自然な生のような方法ではCBNの自然な生のような方法ではCBNの自然な生のような方法ではCBNの自然な生のようなが、でいる。このようなが、でいる。このは超精密加工用の単結晶パイトと、型単結晶の合成が不可欠である。

発明の構成

超高圧下の単結晶育成の例はダイヤモンドについて既に広く知られている。 (例えばUSP3.297.407) CBNの場合も窒化硼素を原料とし、これを適度に溶解する熔媒があれば、温度差による溶解

BasBsN、の1種以上(以下C成分とする)の混合物が窒化硼素の溶解能に優れ、温度差法によるCBN単結晶の合成用溶媒に最適であることを見い出した。これによりミリメートルサイズの高品質大型CBN単結晶の合成が可能になった。

本発明において使用する溶媒が有効に働く組成は、B成分が1~10重量%、C成分が5~30重量%の範囲である。望ましくはB成分1~5重量%、C成分5~20重量%がよい。各成分について2種以上の混合物を用いる場合にはその合計重量が上記の範囲である。又、この溶媒の禍成成分のうちA成分としてはN2B.O.、N2B.O. ( M: アルカリ

度の変化を利用する、いわゆる温度差法により大型単結晶の育成が可能なはずである。

そこで本発明者らが鋭度研究を重ねた結果、アルカリ金属の硼酸塩、アルカリ土類金属の硼酸塩の1種以上(以下A成分とする)LiaN、liaBN,の1種以上(以下B成分とする)SraNa,BaaNa,SraBaN4.

金属) M'sBsOs. M'BsOs. (M': Tルカリ土 類金属) 毎種々のものを用いることができる。 B成分としては、LisNを含むことが望ましい。 LisNを含むことにより生成するCBNは高純度の ものとなる。これは特別昭56-140013号公報で触 れられているようにLisNが不純物を選択的に抽染 するためであると思われる。C成分としてはSrsBsNs 及び/又はBasBsNs を用いたときに特に好結果が 得られた。

本発明において用いる原料窒化硼素としては、 h B N . C B N . W B N . (ウルツ鉱型窒化硼素)、 a B N ( アモルファス状窒化硼素) 等、特に結晶 形は関わない。但し、できる限り高純度のものを 運択する実験では C B N と h B N の混合物を用い たときに最もよい結果が得られた。

本発明を行なう場合の圧力、温度条件は第1図のA域で且つ溶媒物質の融点以上の温度である。 溶媒の融点は、A成分として用いる物質及びその 混合比率、又A,B,C,3成分の混合比率等に より適宜変えることができるので一概には含えな

#### 特開昭62-297203(3)

い。特に前者による効果は大であるので、 A 成分を適当に選択することにより、 特 四 昭 60 - 211848 号に示されているような多段合成も可能である。 以下、実施例により具体的に説明する。

灾 旅 例 1

CBN粉末とhBN粉末を重量で1:1の比に混合して型押、成型し原料とした。溶媒はSrsBsOs. LisN. SrsBsN。を重量で80:5:15 の比で混合し型押、成型して調製した。これらを第2 図に示した試料室に、径約0.7mm のCBN 種結晶 6 ケとともに配置した。これをベルト型超高圧装置に入れ、53 Kb、原料部の温度が1600でになるように加圧、加熱し24時間その条件を保持した后取り出した種結晶は一部溶解しており、溶媒下部に黄色透明で径 1.5~2.0mm のCBN単結晶が残った種結晶上に3ヶ、自発核発生により径 0.5~1mm の結晶が5ヶ生成していた。原料がすべてCBNの場合も同様な結果であった。

寒 施 例 2

爽施例1におけるSr.B.O. にかえてCa.B.O. と

溶媒として K. B. O. T. Li . N. Ba . B . N. A. h B N を 85 : 3:10:2 の重量比に混合したものを用いた以外は、実施例 1 と同じ試料構成にした。 2 重量%の h B N は特明昭 60 - 131811号公報にあるように反応初期の種結晶溶解防止効果を期待したものである。これを 55 K b 原料部の温度 1550でで 3 6時間保持した種結晶上にのみ径約 2.5 mm の 负色透明の C B N 単結晶が成長していた。

発明の効果

以上述べたように、本発明の方法によれば、ミリュートルサイズの大型 C B N 単結晶が再現性よく得られる。これによって、従来は研削に頼っていた鉄系金瓜の超精密切削加工ができるようになり、その効果ははかり知れないものがある。又、C B N 単結晶のバンドギャップの高さ、熱伝導の良さ等を利用した半導体材料への道も開けてきた。4. 図面の何単な説明

第1図は本発明のCBN単結晶合成条件を説明するための窒化硼素の温度、圧力相図である。 第2図は本発明を実施する合成試料室積成の例で これを51Kb原料部の温度1550でで24時間保持したところ、種結晶は溶解していたが、溶媒下部に径

Na BO 2 の 重量比で 4:1 の 混合物 を用いた。

1.6~1.5mm の黄色透明なCBN単結晶が数ヶ自 発核発生により生成していた。

爽 施 例 3

溶媒と種結晶の間に、厚さ 1 mmの Sr. B.O. 円板を挿入した他は、実施例 1 と同様の試料構成にした Sr. B.O. 単独では、 C B N を殆ど溶解しないので反応初期、上部溶媒とこの Sr. B.O. が均一に混じりあうまでの種結晶溶解防止効果が期待された。これを 51 Kb原料部の温度 1600 でで 72時間保持したところ種結晶上にのみ径約 4 maの货色透明の C B N 甲結晶が成長していた。

実施例 4

実施例 3 におけるLiaNにかえて、LiaBNaを用いて51Kb原料部の温度1600℃で48時間保持した径3.5mmのCBN単結晶が得られた。但し、色はやや思みがかっていた。

**実施例5** 

ある。

第 1 図中 A は高圧相型窒化硼素安定域、 B は立方晶一六方晶型窒化硼素平衡線、 C は六方晶型窒化硼素安定域を示す。

1:パイロフイライトスリーブ

2:黒鉛ヒーター

3: 窒化硼素原料

4:溶 媒

5 : CBN 種結晶

6:白金製シードペッド

7: h B N 烧 結体

8: Ta 製容器

代理人 弁理士 上代 哲司



## 特開昭62-297203(4)



